

Stockage flash : Micron se lance dans le 16 nm

Micron vient d'annoncer le lancement de la production de composants flash utilisant des transistors gravés en **16 nm**, contre 20 nm auparavant. Ils utilisent de surcroît des cellules **TLC** (*triple-level cell*), qui stockent 3 bits par cellule et seront donc à réserver à des usages *desktops*.

La durée de vie de ses composants est en effet réduite par rapport aux offres SLC (*single-level cell*, un élément par cellule) et MLC (*multi-level cell*, deux éléments par cellule), mais ceci permet à Micron – en association avec le 16 nm – **de réduire la taille de ses composants de 28 %**. Le coût de ces puces flash devrait donc se montrer en forte baisse, ce qui relancera la guerre des prix sur le marché des SSD et clés USB.

Généralisation du 16 nm

Notez que la firme n'est pas la seule à proposer une telle finesse de gravure. **SanDisk et Toshiba** proposent d'ores et déjà du 15 nm, et **Intel** du 16 nm. **Samsung** est plus flou sur les spécifications de ses composants flash, dont la finesse de gravure effective serait comprise entre 10 et 19 nm. Enfin, **Crucial** a lui aussi montré des composants flash en 16 nm.

Un cap semble donc être franchi dans l'industrie du stockage flash. Cap qui devrait se traduire par des prix toujours plus bas. Aujourd'hui, des SSD de 120, 240, 480 et 960 Go peuvent être trouvés dès **60, 110, 200 et 380 euros TTC**. Des tarifs encore inimaginables il y a 24 mois.

À lire aussi :

[SanDisk multiplie les offres de stockage flash portables](#)

[Intel et Micron promettent des modules flash M.2 de 3,5 To](#)

[Avec InfiniFlash, SanDisk se lance dans la bataille des baies 100% flash](#)